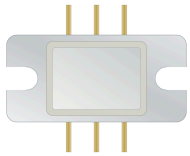
# 9200–10400 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT 45 dBm (標準値)

LCI-PA-9200-10400-PS45T · 9200–10400 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.



RF 電気特性表の規定値: PSAT 45 dBm (標準値); 電力利得 23 dB (標準値); PAE 38 % (標準値). RF 測定条件: Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm.

CMW010B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

パッケージ外形寸法: 18.03 × 8.7 mm.

## RF 特性

Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm

| 項目 | 記号 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作周波数 | f | 9200 | - | 10400 | MHz |
| 飽和出力電力 | - | 44.7 | 45 | - | dBm |
| 電力利得 | - | 22.7 | 23 | - | dB |
| 電力付加効率 | - | 35 | 38 | - | % |
| 電力利得平坦度 | - | - | - | ±1 | dB |

## DC バイアスと電流

| 項目 | 記号 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン電圧 | - | - | - | - | 28 | V |
| ゲート電圧 | - | - | - | - | -2.4 | V |

## 絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

| 項目 | 記号 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大ドレイン・ソース間電圧 | - | - | - | 32 | V |
| ゲート・バイアス下限 | - | -5 | - | - | V |
| 保存温度 | - | -65 | - | 150 | °C |
| 最大入力電力 | - | - | - | 28 | dBm |

## パッケージ外形寸法

| 項目 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| パッケージ外形寸法 | 18.03 × 8.7 | mm |
| 端子全幅 | 14.7 | mm |

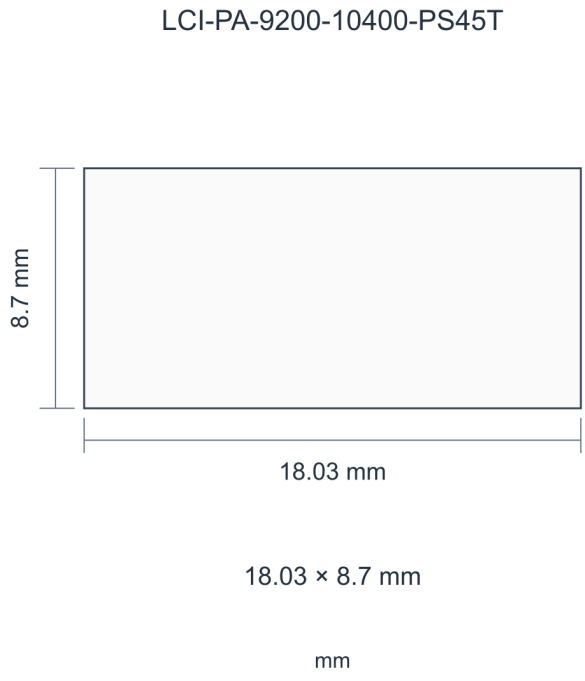
**現在の発行記録** · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

## 実装上の注意

CMW010B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

## 外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

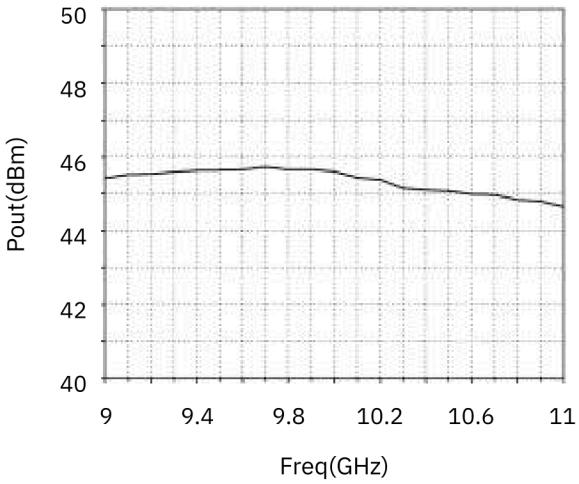


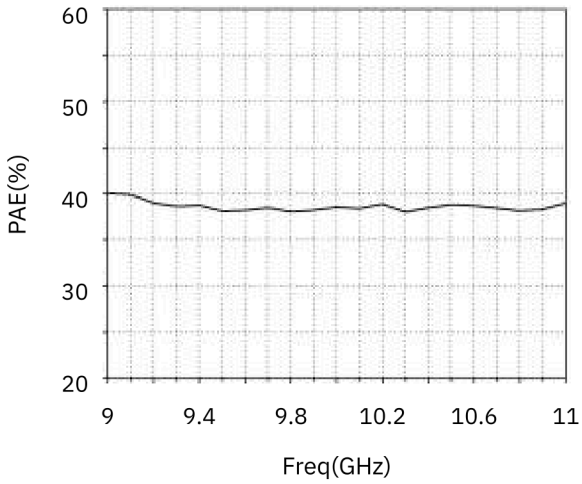
# 性能特性曲線

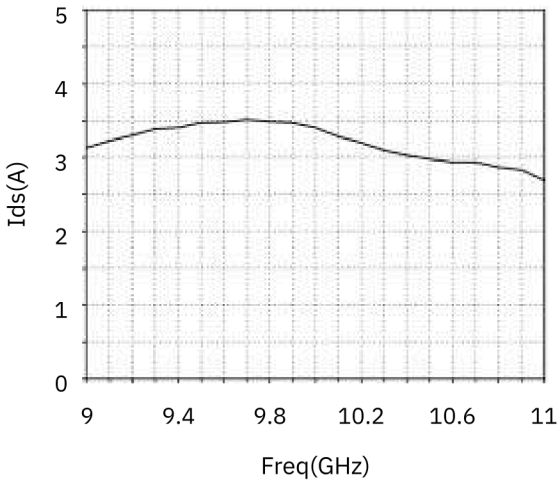
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

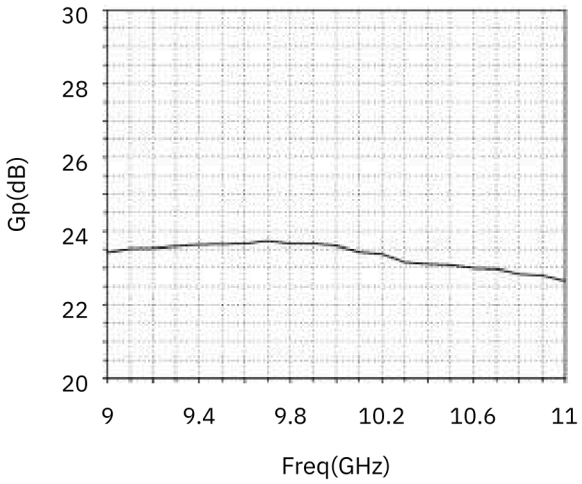
### パルス動作 – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=22dBm。 PW = 100 µs; D = 10%.




**文書に関する注意**

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。